



具有低电流集边效应的金属/氮化镓铝/氮化镓横向肖特基二极管及其制备方法

文献类型: 专利

...

作者 陈家荣; 王玉琦; 陈文锦; 邱凯; 李新化

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 cn101179098

专利类型 发明

权利人 中国科学院合肥研究院

是否PCT专利 是

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2009-11-10; 2009-11-10

申请日期 2006

专利申请号 cn200610097597

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1742>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 陈家荣,王玉琦,陈文锦,等. 具有低电流集边效应的金属/氮化镓铝/氮化镓横向肖特基二极管及其制备方法, 具有低电流集边效应的金属/氮化镓铝/氮化镓横向肖特基二极管及其制备方法, 具有低电流集边效应的金属/氮化镓铝/氮化镓横向肖特基二极管及其制备方法, 具有低电流集边效应的金属/氮化镓铝/氮化镓横向肖特基二极管及其制备方法, 具有低电流集边效应的金属/氮化镓铝/氮化镓横向肖特基二极管及其制备方法. cn101179098. 2008-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览

624

下载

164

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

